

27 04 7

производить приклеиванием. Рекомендуется клей ВК 32,200, а также клей холодного отверждения на основе смол ЭД-5 и ЭД-6.  
Общий вид микросхемы:

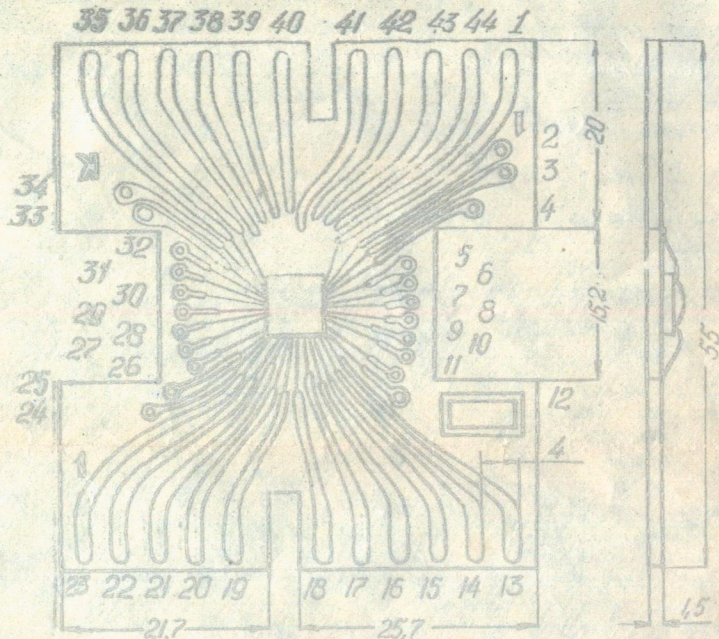


Рис. 3

Нумерация контактов соответствует электрической принципиальной схеме Лэ3.414.000 98.

13. Дата выпуска.

Представитель ОТК

Представитель заказчика

*Александр Волков*  
21С 31137

ПАСПОРТ



Микросхема интегральная полупроводниковая  
типа 712РВ1 серии 712

1. Соответствует техническим условиям Лэ3.414.000 ТУ.
2. Функциональное назначение: диодная матрица емкости 256 бит, предназначенная для работы в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

2041

Наименование параметра	Обозначение	Нормальный параметр	Режим измерения		Примечание
			U пр	U обр	
1. Прямое падение напряжения, В	Ц пр.	не более 0,92	0,5		+25°C
		не более 1,23	1,5		+85°C
		не более 0,90	0,5		минус 60°C
		не более 1,20	1,5		
		не более 1,0	0,5		
2. Суммарный обратный ток строки, мкА	Σ I обр строки	не более 2		6	+25°C
		не более 2		6	минус 60°C
		не более 8		6	+85°C
		не более 100		7	+25°C
3. Суммарная емкость строки, пФ		не более 5			+25°C
4. Предельно-допустимое обратное напряжение на диод, В		7			минус 60°C
5. Предельно-допустимый прямой ток через диод мА		5			+85°C
6. Допустимая мощность рассеяния, мВт		100			



4. Габаритные размеры приведены на рис. 1

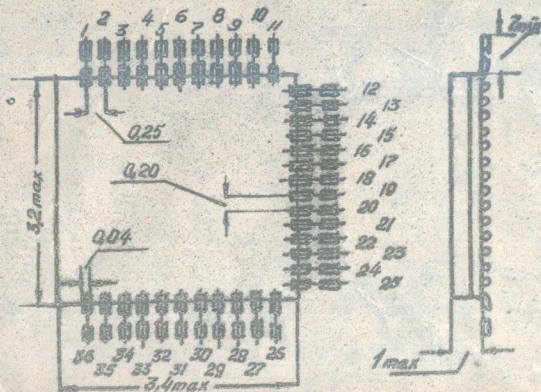


Рис. 1

5. Вес не более 25 мг.
6. Содержание золота в одной микросхеме 0,010 г.
7. Содержание серебра на одной таре-спутнике 0,300 г.
8. Принципиальная электрическая схема:

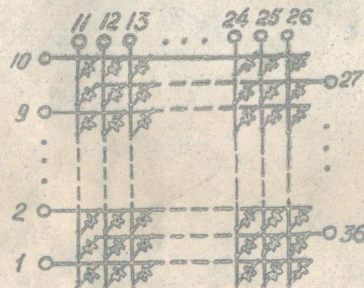


Рис. 2

9. Диапазон рабочих температур: минус 60 - +85°C.
10. Время гарантийной наработки 15.000 часов.
- II. Срок хранения микросхем после герметизации в корпусе или в составе герметизированной аппаратуры не менее 15 лет.

Примечание:  
наличие или отсутствие  
диодов в местах пересечения  
строк и столбцов определя-  
ется кодовой таблицей.

Срок хранения в технологической таре в негерметичной и влагозащищенной упаковке в цеховых условиях в течение 30 суток.

При хранении в отапливаемом хранилище в герметизированной упаковке предприятия-изготовителя - не менее 6 месяцев.

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу микросхем в течение времени гарантийной наработки или срока хранения при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения, а также указаний и рекомендаций по применению и эксплуатации микросхем.

Гарантия исчисляется со дня даты изготовления, нанесенной на микросхеме.

## II. Специальные указания и рекомендации по эксплуатации и установке микросхем.

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды от минус 60°C до +85°C;

климатические воздействия температур в интервале минус 60°C - +25°C;

многократные удары с ускорением до 160 g;

вибрация с ускорением до 40 g в диапазоне частот от 1Гц до 5000 Гц

линейные нагрузки с ускорением до 160 g;

Технология монтажа микросхем в гибридную микросхему должна предусматривать минимальное время пребывания микросхем в цеховых условиях.

При монтаже микросхем в гибридную микросхему гибкие выводы должны закрепляться и натягиваться без натяжения свободных концов выводов.

Режимы и условия монтажа микросхем в аппаратуре.

Технология монтажа должна предусматривать минимальное время пребывания микросхем в цеховых условиях. Рекомендуется применение скаффолдов, обеспечивающих поддержание микроклимата. В случае вынужденных перерывов в технологическом цикле изготовления микросхем, микромодулей, узлов и блоков, а также при осуществлении внутрицеховой транспортировки микросхем они должны находиться в специальной таре в условиях контролируемой среды с влагопоглотителем (и осушателем).

Извлечение микросхем из герметичной заводской упаковки, входной контроль параметров, монтаж микросхем в микромодулях, узлах, в блоках аппаратуры, а также герметизации последних должны осуществляться в условиях контролируемой среды с соблюдением правил вакуумной тигельной при влажности воздуха не выше 65%. После снятия микросхем с тары-спутника гибкие выводы микросхем отрезаются стальными в соответствии с рис. 1. При перенесении схемы на подложку гибридной микросхемы микросхема берется пинцетом за несколько отогнутых выводов.

Выводы микросхем рекомендуется присоединять сваркой. Минимальное расстояние от точки сварки до края кристалла 1,5 мм и не более 4 мм.

При монтаже микросхем должны быть приняты меры, исключающие натяжение выводов и перегрев кристалла микросхем с защитным покрытием выше +180°C. Крепление микросхем на подложку гибридной микросхем